
	<h2>SI7308DN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7308DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7308DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18388 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7308DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18388 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 5.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 19.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7308DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	665pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 6A (Tc) 3.2W (Ta), 19.8W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI7308DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7308DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7308DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7308DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7308DN-T1-E3-PBF VISHAY SI7308DN-T1-E3-PBF VISHAY</p>	 <p>SI7308DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8</p>	 <p>SI7308DN VISHAY SI7308DN VISHAY</p>	 <p>SI7309DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 8A 1212-8</p>
 <p>SI7309DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 8A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7309DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 8A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SI7308DN-TI-GE3 VISHAY SI7308DN-TI-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7309DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 8A 1212-8</p>

SI7308DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7308DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7308DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7308DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7308DN-T1-GE3
SI7308DN-T1-GE3 Electronic	SI7308DN-T1-GE3-Komponenten	SI7308DN-T1-GE3-Verteiler	SI7308DN-T1-GE3-Bild	SI7308DN-T1-GE3-Teil
SI7308DN-T1-GE3 Preis	SI7308DN-T1-GE3 Hersteller	SI7308DN-T1-GE3 Bild	SI7308DN-T1-GE3 Aktie	SI7308DN-T1-GE3 Inventar
SI7308DN-T1-GE3 Neu	SI7308DN-T1-GE3 Original	SI7308DN-T1-GE3 garantiert	SI7308DN-T1-GE3 RFQ	SI7308DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited